








	<p><b>BSP125L6327HTSA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSP125L6327HTSA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 120MA SOT-223</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSP125L6327HTSA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSP125L6327HTSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 120MA SOT-223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 94μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-SOT223-4
Serie	SIPMOS®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	45 Ohm @ 120mA, 10V
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	150pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120mA (Ta)

BSP125L6327HTSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSP125L6327HTSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSP125L6327HTSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSP125L6327HTSA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSP125H6327XTSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 120MA SOT-223</p>	 <p><b>BSP125 H6327</b> INFINEO BSP125 H6327 INFINEO</p>	 <p><b>BSP125H6433XTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 120MA SOT223</p>	 <p><b>BSP125L6327</b> INFINEON BSP125L6327 INFINEON</p>
 <p><b>BSP125L6433HTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 120MA SOT-223</p>	 <p><b>BSP126,135</b> Nexperia USA Inc. MOSFET N-CH 250V 375MA SOT223</p>	 <p><b>BSP127</b> NXP BSP127 NXP</p>	 <p><b>BSP126</b> NXP BSP126 NXP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSP125L6327HTSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSP125L6327HTSA1 Datenblatt	BSP125L6327HTSA1-Datenblätter	BSP125L6327HTSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSP125L6327HTSA1
BSP125L6327HTSA1 Electronic	BSP125L6327HTSA1-Komponenten	BSP125L6327HTSA1-Verteiler	BSP125L6327HTSA1-Bild	BSP125L6327HTSA1-Teil
BSP125L6327HTSA1 Preis	BSP125L6327HTSA1 Hersteller	BSP125L6327HTSA1 Bild	BSP125L6327HTSA1 Aktie	BSP125L6327HTSA1 Inventar
BSP125L6327HTSA1 Neu	BSP125L6327HTSA1 Original	BSP125L6327HTSA1 garantiert	BSP125L6327HTSA1 RFQ	BSP125L6327HTSA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited